法政大学学術機関リポジトリ

HOSEI UNIVERSITY REPOSITORY

PDF issue: 2024-07-27

表皮効果削減のための高周波断面形状の最適 化

KURODA, Kohei / 黒田, 洪平 / SAITO, Yoshifuru / 齊藤, 兆 古

(出版者 / Publisher)
法政大学情報メディア教育研究センター
(雑誌名 / Journal or Publication Title)
法政大学情報メディア教育研究センター研究報告
(巻 / Volume)
20
(開始ページ / Start Page)
79
(終了ページ / End Page)
82
(発行年 / Year)
2007-03-20
(URL)
https://doi.org/10.15002/00002029

表皮効果削減のための高周波断面形状の最適化

黒田 洪平 齋藤 兆古 法政大学大学院工学研究科

電気電子機器に使用される全ての導体における高周波動作は表皮効果を喚起させてしまう.特に現代の高速なコンピュータ内部の高周波駆動するバスは熱損を引き起こす大きな表皮効果が起きる.

本論文では、我々は多様な断面形状持つ導体高周波な電流を流した時の表皮効果の可視化を試みる。表 皮効果の可視化により,電流分布が均一になるような最適な断面形状を持つ導体の探求を試みる。つまり銅損 の可能な限り最小にする導体断面形状の最適化ということを意味する。

表皮効果などの電流分布の可視化することはヘルムホルツ方程式を解くことを本質としている。我々は等価 回路を用いることにより変微分方程式を減らす準解析的手法を採用する。等価回路に流れる枝電流を求めるこ とによって電流分布の可視化を行う。

1. はじめに

近年、ノートPCに代表される小型軽量電子機器の普及は 目覚しいものがある。電子機器は信号処理を行なう電子回路 と電力を供給する電源部からなり、何れも小型・軽量のために 高周波動作が採用されている。それ故、回路素子間を繋ぐワ イヤーには必然的に表皮効果(skin effect)が喚起される。この 結果として、電流の流れる導体の実効断面積が減少する。い わゆる交流抵抗が増加し、周波数の上昇と共に導体損失の 増加が発熱問題を喚起する。また、磁気エネルギーを蓄積す る磁気素子は高周波動作を前提とする傾向が強まり、集中定 数的な回路定数とする考え方が困難になり、分布定数的な考 え方をせざるを得ない。このため、高周波動作を前提とする 磁気素子は、媒質や幾何学的形状で決定されるインダクタン スや抵抗を一定値とみなせず、周波数の関数として変化する パラメータとして考えざるを得ない。この意味で、電気・電子 機器解析技術者が最終的に必要とする結果は装置や素子の モデリングや離散化法技術などに習熟しなければ期待できる 結果が得られない。これは、小型軽量化された電子機器中の 微細化されたワイヤー断面の電流分布を解析するまでの道 程は未だ遠いといえる。しかし、現実問題として導線に高周 波電流を通電する場合、必然的に表皮効果が伴い導線の有 効断面積が減少し、結果として発熱や電源効率の低下に繋 がっている可能性は否定できない。

本稿は、このような現状に鑑み、高周波電流を通電する導 体断面の表皮効果を可視化し、高周波の電流が可能な限り 均一に導体断面に分布する最適な導体断面形状を求める研 究の第1段階である。

表皮効果はヘルムホルツ型偏微分方程式の解として求ま るため何らかの方法でヘルムホルツ型偏微分方程式を解く必 要がある。本稿では、解析者が偏微分方程式を意識しなくて も表皮効果が可視化可能な準解析的離散化法を解析法とし て採用する^{1,2}。

準解析的手法とは、如何なる複雑な形状の導体も微少丸 形導体に分割可能と仮定する。そして、微少丸形へ古典的 解析法であるノイマンの公式を用いてインダクタンスなどを計 算し、最終的には電気回路へ偏微分方程式を変換して解析 する手法である。

表皮効果は、導体中に電流が流れることに起因する磁界 から生ずる逆起電力の不均一分布に拠る結果である。本論 文では、表皮効果を喚起する原因に着目した結果、磁界分 布の均一化は逆起電力の均一化を意味し、結果として表皮 効果が削減されると仮定する。本論文では、この仮定に基づいて高周波用導体断面形状の最適化を試みた一例を報告 する。

2. 基礎理論

2.1 準解析的電磁界解析法

ここでは、本論文で採用する準解析的電磁界解析法の原 理を説明する.

2.1.1 モデリング

任意形状導体の具体例として Fig.1(a)に示す直角二等辺三 角形の断面形状を有する導体を考える。この導体をすべて同 じサイズの微小丸型導体(円柱状)の集合に置き換える。モ デリングは、最初に導体の断面積対長さの比が無視できない 場合、すなわち,微少丸形導体そのものの表皮効果が無視 できない場合、導体断面をより微小な円形断面の集合へ置き 換える。Fig.1(a)の場合,Fig.1(b)のようなモデルで微少導体 そのものの表皮効果が無視できると仮定する。ここで,全微小 丸型導体の体積の和は供試導体の全体積と等しいとする。こ れは、丸型導体の分割個数を無限大にした場合、供試導体 を再現可能とする条件である。



Fig.1 Modeling of a test conductor

個々の微小丸型導体の内部抵抗や自己インダクタンスはそ れぞれ解析的に計算でき,式(1a)、(1b)でそれぞれ与えられ る.さらに、分割された導体間の相互インダクタンスは式(1c) で与えられる。したがって、Fig.1(b)の個々の導体を内部抵抗 と自己インダクタンス、および通電方向を勘案すれば、Fig.1 (b)のモデルから Fig.1(c)に示す等価回路が得られる。

$$r = \sigma \frac{l}{S} \tag{1a}$$

$$L = \frac{\mu_0}{8\pi} + \frac{\mu_0 l}{2\pi} \left(\log \left(\frac{2l}{r'} \right) - 1 \right)$$
(1b)

$$M_{ij} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \left(\log \left(\frac{l + \sqrt{l^2 + d_{ij}^2}}{d_{ij}} \right) - \sqrt{1 + \left(\frac{d_{ij}}{l} \right)^2 + \frac{d_{ij}}{l}} \right)$$
(1c)

2.1.2 システム方程式

Fig.1(c)の等価回路から正弦波定常状態のインピーダンス行 列Zは以下のようにあらわされる。

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} r_{1} + j\omega L_{1} & j\omega M_{12} & \cdot & j\omega M_{1m} \\ j\omega M_{21} & r_{2} + j\omega L_{2} & \cdot & j\omega M_{2m} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \vdots & \ddots & \cdot & \cdot \\ j\omega M_{m1} & j\omega M_{m2} & \cdot & \cdot & r_{m} + j\omega L_{m} \end{bmatrix}$$
(2a)

また,入力電圧ベクトルと出力電流ベクトルをそれぞれ, V,Iとすれば、次のシステム方程式を得ることができる。

$$\mathbf{V} = \mathbf{Z}\mathbf{I}$$

よって, 求める電流分布ベクトルIは次式で与えられる。

$$\mathbf{I} = \mathbf{Z}^{-1} \mathbf{V}$$
(2b)
ここで 供試道体の両端の電圧を v とし、断面の分割個数を

ワ町峏 mとすれば、入力電圧ベクトルと出力電流ベクトルはそれぞ れ次式で与えられる。

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} v & v & \bullet & v \end{bmatrix}^T$$
(2c)

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} i_1 & i_2 & \bullet & i_m \end{bmatrix}^I \tag{2d}$$

ここで, *i_n* (n=1,2,…,m)は Fig.1(c)の等価回路中の電流であ る。また、電流 i が直線状の導体を流れている時の周辺磁界 Hは、cを磁界Hの経路、dlをcの微小線分として

$$\int \mathbf{H}dl = j \tag{2e}$$

С で与えられる。

特に、磁界 H の経路を導体の外側で導体の中心からr の円 周とすれば、式(2e)から円周方向磁界の大きさは、

(2f)

$$H = \frac{j}{2\pi r}$$

で与えられる。

よって、i番目の丸型微小導体に鎖交する磁界Hは、

$$H_i = \sum_{n=1}^m \frac{I_n}{2\pi i_n} , \quad n \neq i$$
 (2g)

ここで、I., r.は、それぞれ n番目の微小導体に流れる電流とi 番目とn番目の微小導体間の距離を示す。³⁾

2.2 例題

2.1 節で述べた方法を Fig.1(a)に示す供試導体に適用した 結果に関して述べる。

供試導体の材質は銅であり、その抵抗率は 1.72×10⁻⁸[Ωm] である。また、大きさは底辺の長さを 0.5[cm]とし、長さ 30[cm] とする。Figs.2,3 は、それぞれ印加電圧の周波数を(a)50[Hz], (b)1[kHz], (c)1[MHz]とした場合の定常状態電流分布と磁界 の強さ分布であるである。尚、この例では丸型微小導体の数, すなわち、供試導体の分割個数mは 1275,印加電圧の実効 値は1[mV]である。



(a) 50Hz (b) 1kHz



Fig.3 Magnetic field intensity distributions. White: High, Dark: Low

Figs.2,3 で、白色部が電流と磁界の振幅が大きく、黒色に近 いほど電流と磁界の振幅が小さいことを示す。したがって、 Figs.2,3は、低周波では電流が均一に分布し、周波数が増加 するほど導体表面部分へ電流が集中し、いわゆる表皮効果 を可視化している。特に、三角形の各頂点に電流が集まるこ とが興味深い。これは三角形の頂点を取り囲む磁界が最も少 なく、その結果、磁界による逆起電力が小さいためである。

3. 電流分布と磁界分布の関係

2 章で扱った供試導体とそれに対称な導体を用いて、Fig.4 の様に並べた場合の電流分布と磁界分布をそれぞれ Figs.5,6 に示す。Fig.5 では印加電圧の周波数をそれぞれ (a)50[Hz],(b)1[kHz],(c)1[MHz]とした。

Fig.6(a),(b),(c)は Fig.5 に示す電流分布に伴う磁界分布であ る。また、分割個数mは 1260, 印加電圧は 1[mV]とした。



Fig.4 Two tested conductors.







(a)50Hz

(b)1kHz (c)1MHz Fig.5 Current distributions. White: High, Dark: Low



(a)50Hz (b)1kHz (c)1MHz Fig.6 Magnetic field intensity distributions White: High, Dark: Low.

Fig.3 と Fig.5 を比較すれば、明らかに1 個の導体よりも2 個 の導体の並列とすれば、電流分布は均一となることが判る。 磁界と電流の関係はアンペアの法則式(2e)で与えられるから、 Figs3,6 で、電流を中心として右ねじ方向へ磁界が取り囲んで いる。導体を2 個へ分離することで電流を取り囲む磁界が互

いに中心部で打ち消すため、結果として電流も磁界も均一に 分布する傾向を取る。個々の導体としては、電流分布は表皮 効果が低減され、電流が均一に分布する。しかし、導体が分 布する空間の広がりは増加する。

Fig.3 の結果をふまえ、完全に導体が分離しない形で電流分 布を均一化する。Fig.7 に示す導体断面形状を考える。Fig.7 の導体で、横幅を2[cm],高さ0.5[cm],長さ30[cm]とする。



White: High, Dark: Low

Figs.8,9 は Fig.7 の導体を分割個数mは 1300, 印加電圧は 1[mV]とし、それぞれ電流と磁界分布を示す。

Fig.8 の結果は、類似した形状に変形した導体断面でも通常 の導体と同様に中心部で最も表皮効果が大きく、電流密度が 低下することが判る。これは、導体が分離していないため導体 全体を取りか囲む磁界が存在し、この磁界の逆起電力が中 心部で最も大きいためである。

比較のため、Fig.10 に示すように Fig.9 と同一断体積の正方 形断面を持つ導体について電流分布と磁界分布を計算した。



この導体を分割個数m=1225,印加電圧 1[mV]とし、電流分布と磁界分布を以下の Figs.11,12 に示す。



Figs.11,12 の結果は、明らかに単純な角形導体では表皮効 果が分散されない、このため全体としての表皮効果が顕著と なり、結果として導体の有効断面積が減少する。他方、導体 断面を可能な限り導体全体を取り囲む磁界を削減する導体 断面形状は表皮効果を削減し、導体の有効断面積を増加す る。

4. まとめ

本論文では、まず簡単な形状を持つ任意の導体を例として 取り上げ、準解析的電磁界解析法による導体断面上の電流 分布と磁界分布についての基礎理論について述べた。その 結果、準解析的法による等価回路化法はヘルムホルツ型偏 微分方程式を意識することなく表皮効果の可視化を可能とす ることを述べた。

以上の原理検証結果をふまえ、単純な断面形状の導体と導体断面全体を取り囲む磁界を削減する形状の導体の表皮効果を比較し、単純な角形導体では表皮効果が分散されないため全体としての表皮効果は顕著となり、結果として導体の有効断面積が減少した。他方、導体断面を可能な限り導体全体を取り囲む磁界を削減する導体断面形状は表皮効果を削減し、導体の有効断面積を増加する可能性を明らかにした。

参考文献

[1] T.Takano, S.Hayano, and Y.Saito: Coil impedance computation having arbitrary geometrical shape, IEEE PESC'98, Vol.2, (May.1998), pp. 1991-1996 [2]Yasuyuki Watazawa, Seiji Hayano and Yoshifuru Saito : Semi-analytical electromagnetic field Computation, Int. J. Appl. Electromagn. Mater. Vol.15,Nos.1-4, pp. 353-357, IOS Press(April.2002) [3]齋藤兆古、早野誠治:応用電磁工学入門, 産図テ キスト, 2000 年, pp28-33 キーワード.

準解析的手法、表皮効果、最適形状化

Summary.

Shape Optimization of High Frequency Current Carrying Conductor by Skin Effect Visualization

Kohei Kuroda Yoshifuru Saito Graduate School of Engineering, Hosei University

High frequency operation of all conductors used in electrical/electronic devices causes the skin effect in the current carrying conductors. In particular, employing high frequency system bus in modern high speed computer leads to the serious skin effect, which is one of the causes of thermal loss.

In the present paper, we try to visualize the skin effect in various frequencies when flowing high frequency current in the conductors with various cross sectional shapes. Referring to the visualization of skin effect, we try to searching for the optimal cross sectional shape of conductor distributing the currents uniformly. This means that the conductor having optimal cross section is capable of flowing high current without high thermal cupper loss. To visualize the current distribution, i.e., skin effect, it is essential to solve one kind of Helmholtz equations. We employ a semi-analytical method which reduces the partial differential equation into a set of equivalent electric circuits. Evaluation of each of the branch currents of the equivalent electric circuits visualizes the current distribution reflecting the skin effect.

Keywords.

Shape optimization, Skin effect, Semi-analytical approach